

### 关键指标

频率: 2~6GHz  
 功率增益: 20dB  
 1dB 压缩点输出功率: 25dBm  
 饱和输出功率: 27dBm  
 功率附加效率: 34%  
 电压/电流: +5V/240mA  
 芯片尺寸: 2.1mm×2mm×0.1mm

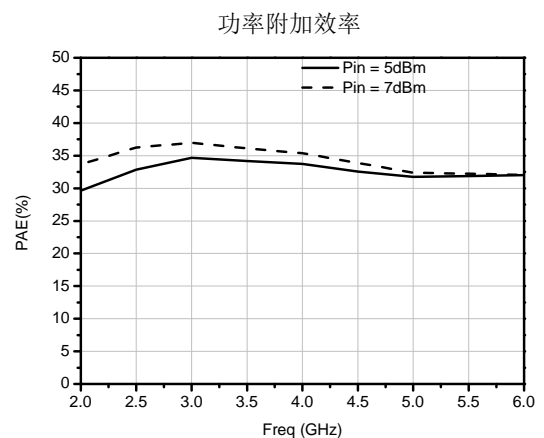
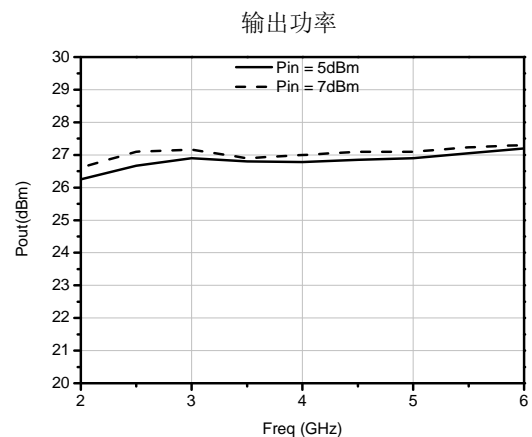
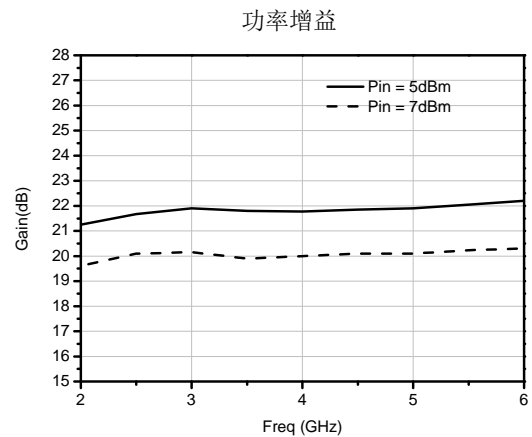
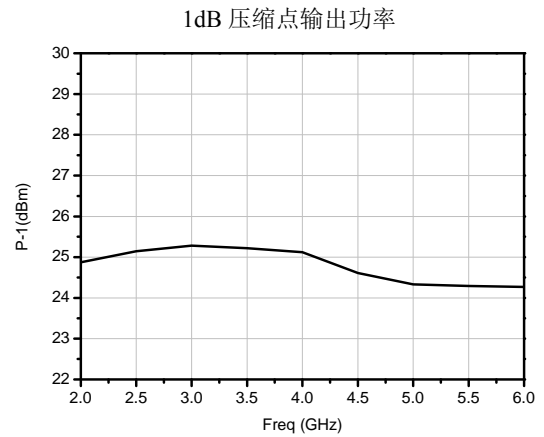
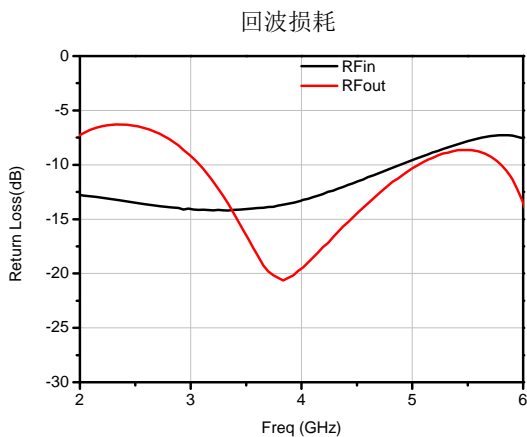
### 产品简介

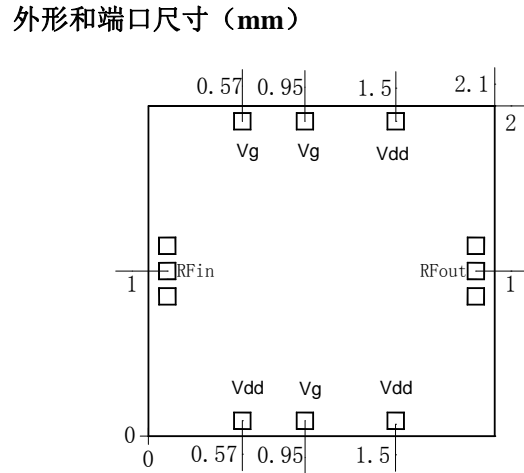
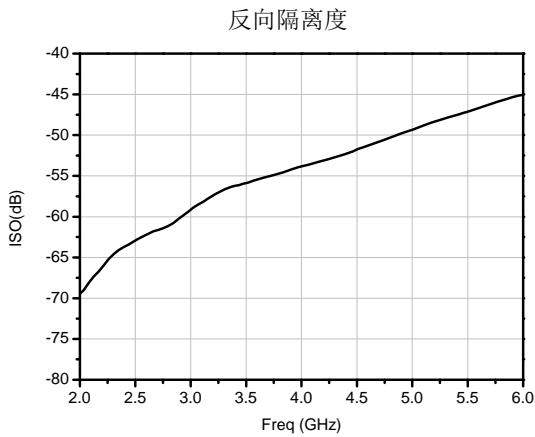
HG124FD 是一款 2~6GHz 功率放大器芯片, 功率增益为 20dB, 饱和输出功率为 27dBm, 功率附加效率为 34%。

### 电性能 ( $T_A=25^{\circ}\text{C}$ , $V_{dd}=+5\text{V}$ , $V_g=-1\text{V}$ )

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~6		
功率增益(dB)	-	20	-
增益平坦度(dB)	-	$\pm 0.5$	-
输入驻波	-	1.7	-
输出驻波	-	2	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	25	-
饱和输出功率(dBm)	-	27	-
功率附加效率	-	34%	-
静态电流 (mA)	-	240	-

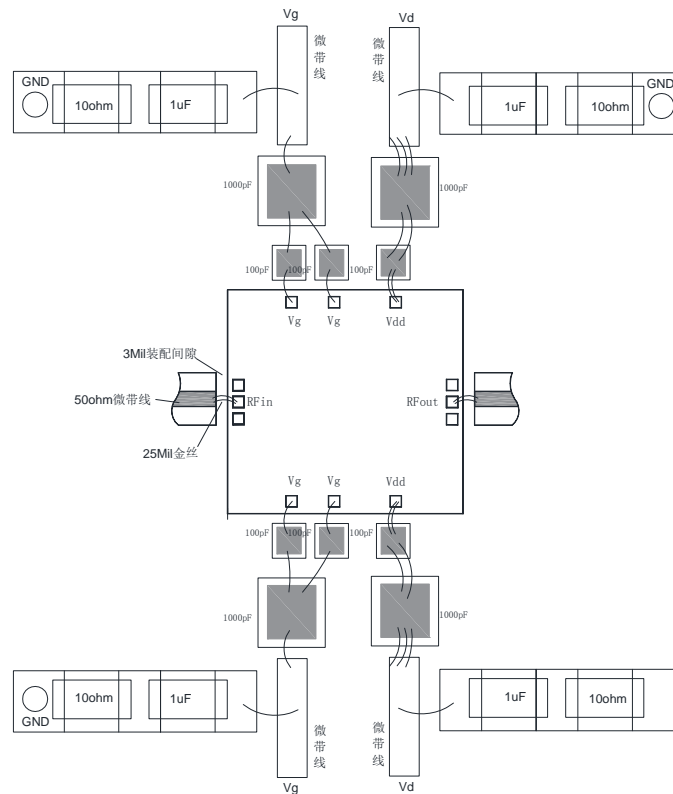
### 典型测试曲线





### 推荐装配图

注意：滤波电容要离芯片压点尽量近，尽量减少金丝长度影响



### 绝对额定最大值

电源电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50μm 双金带键合，建议金带长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。